

PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波増幅用

特 徴

- オーディオアンプのプリドライバ用に最適です。
- 2SC1940とコンプリメンタリで使用できます。
- 小形で全損失が大きく、高耐圧です。

$P_T = 1.0 \text{ W}, V_{CE0} = -120 \text{ V}$

絶対最大定格 ($T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-50	mA
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-100	mA
全 損 失	P_T	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

*PW \leq 10 ms, Duty Cycle \leq 50 %

電気的特性 ($T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

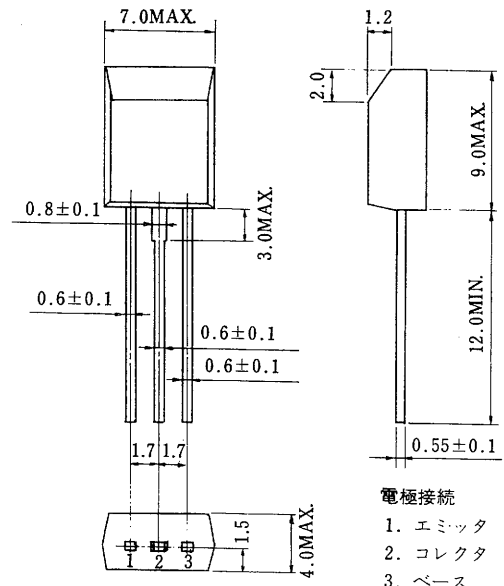
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -120 \text{ V}, I_E = 0$			-100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0 \text{ V}, I_C = 0$			-100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1}	$V_{CE} = -10 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ mA}$	50	200		
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2}	$V_{CE} = -10 \text{ V}, I_C = -10 \text{ mA}$ *	90	200	400	
直 流 ベ ー ス 電 圧	V_{BE}	$V_{CE} = -10 \text{ V}, I_C = -10 \text{ mA}$ *	-650	-695	-750	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -20 \text{ mA}, I_B = -2.0 \text{ mA}$ *		-0.18	-0.6	V
べ ー ス 飽 和 電 圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -20 \text{ mA}, I_B = -2.0 \text{ mA}$ *		-0.79	-1.0	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10 \text{ V}, I_E = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$		2.5	3.5	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -10 \text{ V}, I_E = 10 \text{ mA}$	50	80		MHz

*パルス測定 PW \leq 350 μ s, Duty Cycle \leq 2 %

h_{FE} 規格区分

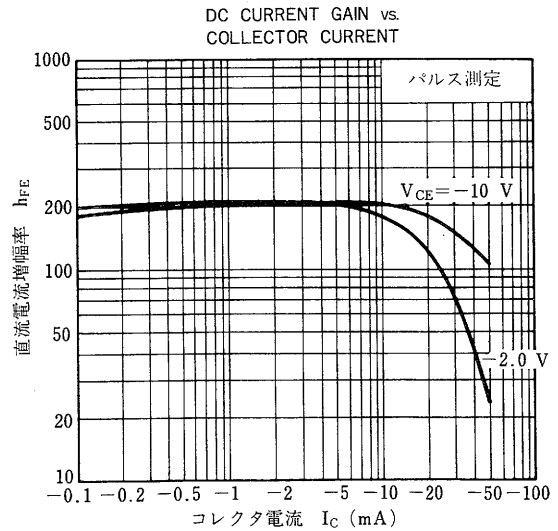
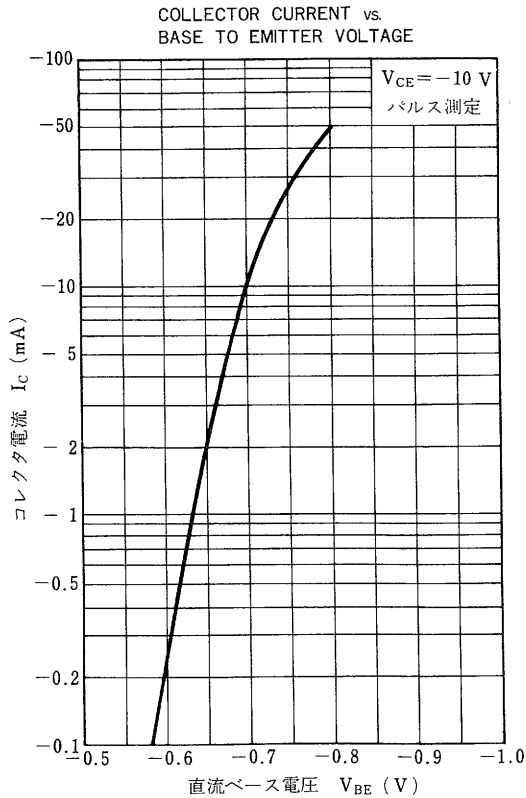
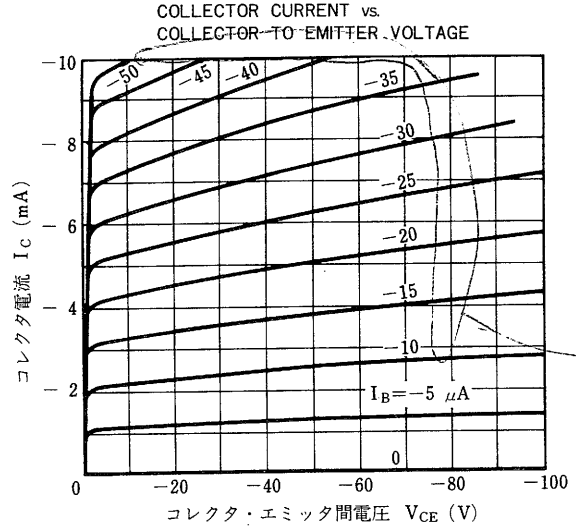
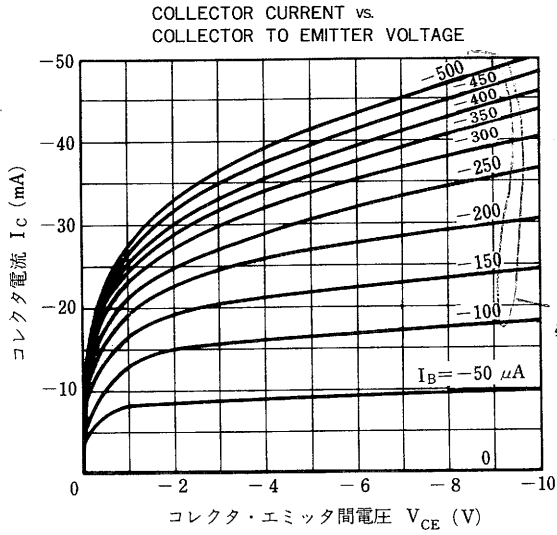
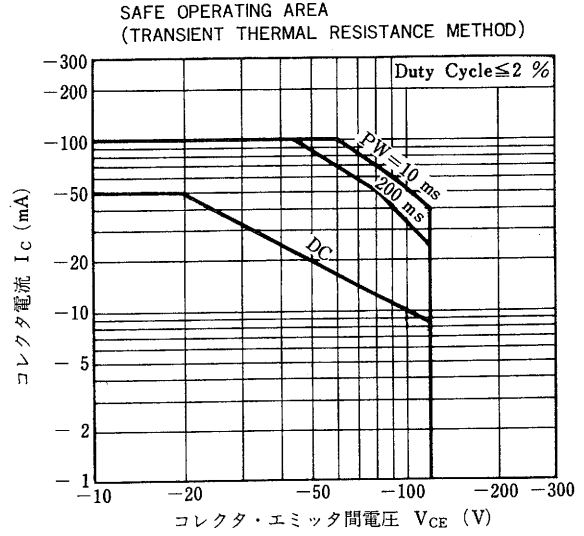
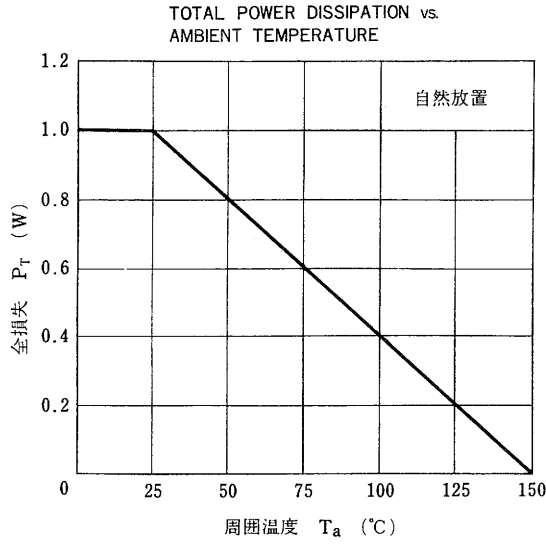
捺 印	M	L	K
h_{FE2}	90~180	135~270	200~400

外形図 (単位: mm)

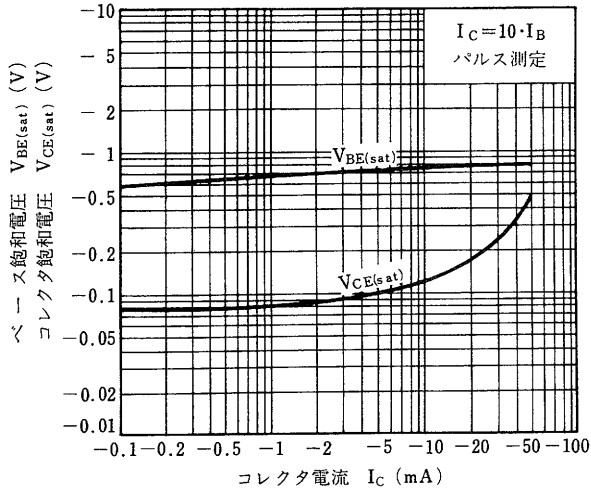


- 電極接続
1. エミッタ
2. コレクタ
3. ベース

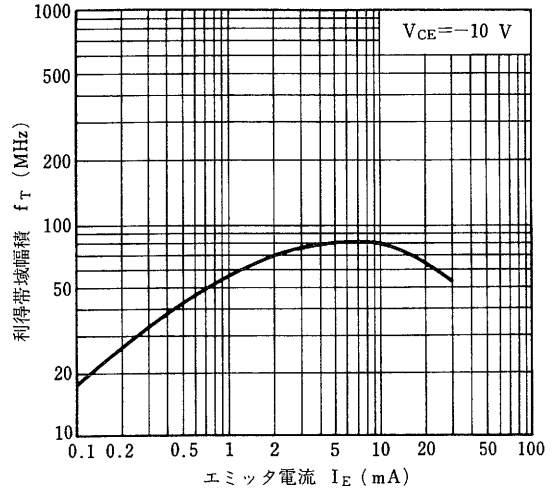
特性曲線 ($T_a=25^\circ\text{C}$)



COLLECTOR AND BASE SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



INPUT AND OUTPUT CAPACITANCE vs. REVERSE VOLTAGE

